



圖 3-6 (a)理想 MOS 電容（在此之矽基底為 p 型）在正閘極偏壓下的能帶圖 (b) 反轉情況下的電荷分布。

將 (3.14a)、(3.21) 和 (3.22) 式代入上式，可得到理想 n-MOS 的 V_T 表示式：

$$V_T = 2\psi_B + \frac{qN_A W_m}{C_{ox}} = 2\psi_B + \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A (2\psi_B)}}{C_{ox}} \quad (3.30a)$$